2U3UUSUUP 2UUГUՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՉԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Հայաստանի քիմիական հանդես 63, №2, 2010 Химический журнал Армении

ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 536.45:536.627:541.115:[546.77+546.281]

ОСОБЕННОСТИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МИКРО-НАНОРАЗМЕРНОЙ ДИФФУЗИОННОЙ ПАРЕ Мо/Si

М. А. АГАЯН^{1,2}, А. А. ЧАТИЛЯН² и С. Л. ХАРАТЯН^{1,2}

¹ Ереванский государственный университет Армения, 0025, Ереван, ул. А.Манукяна, 1 ² Институт химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения Армения, 0014, Ереван, ул. П.Севака, 5/2 Email: suren@ichph.sci.am, suren@ysu.am

Поступило 10 V 2010

Изучены макрокинетические особенности механизма взаимодействия молибдена с кремнием в существенно неизотермических условиях на уровне одиночной частицы металла, покрытой слоем кремния (диффузионная пара Mo/Si). Исследования проводились в температурно-временной области развития процесса (T=1000-1600°C, t=0.01-3 c), сопоставимой с условиями синтеза дисилицида молибдена в режиме горения. Измерены скорости химического тепловыделения и изучены основные закономерности фазо- и структурообразования в зависимости от толщины кремниевого слоя и скорости нагрева образцов с использованием электротермографического метода. Показано, что в зависимости от толщины слоя кремния регистрируется одно- или двухстадийное тепловыделение, обусловленное различными схемами взаимодействия реагентов: Мо (тв) +Si (тв.) при T < T_{nn}^{Si} и Mo (тв.) + Si (ж) при T > T_{nn}^{Si} .

Рис. 13, табл. 1, библ. ссылок 47.

Благодаря технологически важным характеристикам силициды переходных металлов широко применяются как высокотемпературные материалы в микроэлектронике, аэрокосмической технике, катализе и т.д. В частности, дисилицид молибдена признан одним из лучших высокотемпературных материалов, благодаря высокой точке плавления (2020°С), низкой плотности (6.24 г/см3), сопротивлению к высокотемпературному окислению даже в высокоагрессивных средах (благодаря формированию на поверхности защитной пленки SiO2), металлическому характеру тепло- и электропроводности и т.п. [1-4].

Существует ряд технологических подходов для получения дисилицида молибдена. Традиционно силициды получали методом дуговой плавки [5-6] или силицированием порошка молибдена в электрических печах (печной синтез). Оба этих процесса энергоемкие и требуют длительного времени для получения качественных продуктов. Среди новых методов наиболее известны механохимический синтез [7-9], реакционное спекание [10], самораспространяющийся высокотемпературный синтез (сокращенно CBC процесс) [11-13]. В последнее время CBC привлекает наибольший интерес благодаря высокому энергосбережению, простоте процесса, низкой себестоимости, продуктивности, возможности синтеза чистых материалов благодаря эффекту самоочистки [14,15] и т.д. CBC процесс основан на использовании тепла самой химической реакции для поддержания ее протекания при высоких температурах в режиме самораспространения. Для этого достаточно только инициировать экзотермическую реакцию небольшим внешним тепловым импульсом.

Образование дисилицида молибдена характеризуется высоким тепловым эффектом ($\Delta H = -130 \ \kappa \square \varkappa \square monb$) и соответственно высокой адиабатической температурой горения стехиометрической смеси (Mo+2Si), равной 1650°С. Последняя обеспечивает высокую скорость процесса. Синтез дисилицида молибдена методом CBC был исследован в ряде работ [15-24]. В результате были установлены основные закономерности горения и формирования химического и фазового составов конечных продуктов.

Однако следует отметить, что, несмотря на множество преимуществ СВС процесса, из-за экстремальных условий протекания реакции (высокие скорости и высокие температуры) порой становится затруднительным ее контролировать. Для решения данного вопроса важно установление истинного механизма процесса в реальных условиях его протекания. Было предложено несколько моделей формирования силицидных фаз в процессе СВ синтеза, включая реакционную диффузию [15,19,25], растворение металла в жидком кремнии с дальнейшей кристаллизацией MoSi₂ из пересыщенного расплава [19,26]. Однако некоторые важные аспекты механизма п роцесса до сих пор остаются не выясненными.

Много работ посвящено изучению реакционной диффузии и кинетики роста силицидных фаз в изотермических условиях на модельных системах [27-38]. Последние обычно представляют собой диффузионные пары Mo/Si, Mo/MoSi² или Mo/Mo₅Si₃. В результате были выявлены основные закономерности фазообразования в изотермических условиях и определены коэффициенты диффузии кремния в силицидных фазах молибдена.

В работе [39] исследована кинетика тепловыделения при нагреве диффузионной пары Mo/Si в неизотермических условиях в зависимости от толщины кремниевого

слоя (δsi), осажденного на поверхности молибденовой нити диаметром 100 *мкм*. Исследования проводились при δsi=0.25-5.0 *мкм*. Было установлено, что во всем исследованном диапазоне δsi уменьшение толщины слоя кремния приводит к существенному увеличению скорости химического тепловыделения, наблюдаемого сразу после плавления кремния. Данному явлению до сих пор не дано исчерпывающего объяснения. Остается открытым также вопрос, чем ограничена эта скорость и насколько она может расти при дальнейшем уменьшении толщины слоя кремния. Кроме того, в литературе не уделено должного внимания также стадии взаимодействия кремния с молибденом, имеющем место при температурах ниже точки плавления кремния и проявляющемся особенно отчетливо при высоких скоростях нагрева образцов и малых толщинах слоя кремния.

Целью настоящей работы являлось изучение макрокинетических особенностей механизма взаимодействия молибдена с кремнием в существенно неизотермических условиях на уровне одиночной частицы металла, покрытой слоем кремния, в широком, ранее не изученном диапазоне толщины кремниевого слоя с использованием оригинального электротермографического метода. Данный подход позволяет проводить прямые безынерционные in situ измерения скорости химического тепловыделения, а также следить за фазо- и структурообразованием в реальной температурновременной области развития процесса, сопоставимой с условиями синтеза дисилицида молибдена в режиме горения.

Нужно отметить, что толщина слоя кремния на частице Мо в данном случае имеет двоякий смысл: с одной стороны, она характеризует Si/Mo отношение, а с другой – моделирует тот размер частицы металла, которому соответствует та или иная стехиометрия образовавшегося продукта Mo-Si, в частности Mo:Si=1:2, при полном превращении реагентов. В данной работе исследования проводились преимущественно в диапазоне изменения толщины слоя кремния $0.01 \le \delta_{Si} \le 1$ *мкм*, охватывающего также наноразмерную область частиц металла. Для зависимости толщины слоя кремния от радиуса сферической частицы Мо (гмо), соответствующей ее полному превращению в однофазную MoSi₂, легко можно вывести следующее выражение:

$$\delta_{\rm Si} = r_{\rm Mo} \left[(2M_{\rm Si}/M_{\rm Mo}) \cdot (p_{\rm Mo}/p_{\rm Si}) + 1 \right]^{1/3} - r_{\rm Mo} , \qquad (1)$$

где M_{Si}, p_{Si} и M_{Mo}, p_{Mo} – атомный вес и плотность кремния и молибдена, соответственно.

Экспериментальная часть

Исследования проводились электротермографическим методом [40] на быстродействующей сканирующей электротермографической установке (БСЭТ) [41,42], подключенной к персональному компьютеру. В опытах образцы, представляющие собой Мо-нити (99.97 %, ESPI Metals) диаметром 100 *мкм* и рабочей длиной 8.5 *см*, покрытые слоем кремния различной толщины, нагревались прямым пропусканием постоянного электрического тока. Компьютерный контроль обеспечивал проведение опытов по заранее заданному температурному режиму, а также непрерывный и автоматический сбор и обработку экспериментальных данных (температура нити, электрическая мощность, выделяемая на нити, электросопротивление нити).

Перед опытом Мо-нити подвергались рекристаллизационному отжигу в вакууме ($P<10^{-3}$ *Торр*) при T=1500°C длительностью 10 *с*. После такой вакуумной термообработки холодное электросопротивление нити (R_{20}) соответствует минимальному табличному значению. Измерения температуры нити проводились с помощью термостатированных кремниевых солнечных элементов (с постоянной времени 10^{-5} *с*) с использованием ИК-фильтров. Для калибровки фотодатчиков использовалась известная зависимость электросопротивления Мо-нити от температуры. Ошибка измерения температуры не превышала 1%.

Приготовление Si/Mo диффузионных пар проводилось нагревом Мо-нитей в среде разбавленного силана (4% SiH₄+96% Ar) при P_{SiH₄}=2 *Торр* и T=600°C. Гетерогенный распад силана на поверхности нити обеспечивал строго контролируемую и измеряемую скорость осаждения кремния. Типичные микрофотографии поверхности Мо-нитей до и после осаждения слоя кремния показаны на рис.1. Выбранные условия позволили получить относительно однородные кремниевые покрытия на поверхности Мо без заметного взаимодействия с металлической основой. Последнее подтверждалось металлографическим и электронно-микроскопическим исследованиями.



Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки поверхности молибденовых нитей: а – исходная Мо-нить, б – покрытая слоем кремния δ_{SI}= 0.2 *мкм*.

В данном исследовании диффузионные пары Si/Mo толщиной слоя кремния от 0.01 до 1 мкм (в некоторых экспериментах до 3-5 мкм) нагревались в атмосфере гелия при PHe=600 Topp с постоянной скоростью (линейный нагрев: Vн = 4.103÷75.103 о/с) до температуры 1600°С, которая далее поддерживалась постоянной. Использование гелиевой среды обеспечивало максимальную скорость теплоотвода, тем самым позволяя измерять более высокие значения скорости химического тепловыделения. При более низких уровнях теплопотерь (например, в атмосфере Ar) часто имело место отклонение температуры от предварительно заданного пути, и возникали перегревы образцов [39].

Для того, чтобы проследить за фазовым и структурным превращениями, образцы с относительно толстым слоем кремния (δ Si=1 мкм) были закалены на различных стадиях развития процесса путем автоматического отключения электронагрева. Последнее обеспечивало среднюю скорость закалки, равную Vз=25000o/с в температурном интервале от Tмакс=1600 до 1000°С. Микроструктура силицидных фаз исследовалась с использованием оптической (Jenavert, Carl Zeiss Jena) и сканирующей электронной микроскопии (BS-300, Tesla, CZE, а также FESEM S-4700, Hitachi, Japan). Идентификация фаз была сделана с помощью рентгеноспектрального микроанализа (energy-dispersive X-ray spectrometry (EDS: System SIX Mod. 300, Thermo NORAN Corp., USA)). Для исследования поперечного сечения нитей были приготовлены металлографические микрошлифы. Последние подвергались тщательной шлифовке алмазными пастами марки ACM с разной величиной зерна. Изучение микроструктуры и измерение толщин силицидных слоев проводились после окончательной шлифовки алмазной пастой ACM1/0 и травления свежеприготовленным реактивом Мураками (15 г K3Fe(CN)6, 2 г NaOH, 100 мл дистиллированной воды) в течение 2-5 с.

Измерение скорости химического тепловыделения. Главным достоинством применяемого подхода является возможность измерения *in situ* скорости химического тепловыделения (dq/dt) и определения вида кинетической функции в рамках одного эксперимента (одного образца) для произвольного температурного режима взаимодействия.

Скорость химического тепловыделения определяется с использованием уравнения теплового баланса как разность электрических мощностей, выделяемых на нити при первом – реакционном ($P_1(t)$), и втором – инертном ($P_2(t)$), нагревах (с одинаковым температурно-временным режимом).

При первом нагреве (с химическим тепловыделением):

$$c\rho \frac{\mathrm{d}}{4} \frac{\partial T}{\partial t} = P_1(t) + \left(\frac{dq}{dt}\right) - h(T) \tag{1}$$

При втором нагреве (после завершения реакции: dq/dt=0):

$$c\rho \frac{\mathrm{d}}{4} \frac{\partial T}{\partial t} = P_2(t) - h(T) \tag{2}$$

Для скорости химического тепловыделения имеем:

$$\frac{dq}{dt} = P_2(t) - P_1(t) \,. \tag{3}$$

Уравнение 3 верно как в изотермическом, так и неизотермическом режимах взаимодействия. В уравнениях 1-3 приняты следующие обозначения: h(T) – уровень теплопотерь с поверхности нити в окружающую среду, с, Δ , r₀ – удельная теплоем-кость, плотность и радиус нити, соответственно.

Результаты экспериментов

На рис. 2 представлена типичная зависимость скорости тепловыделения от времени, полученная при нагреве Мо-нити, покрытой слоем кремния толщиной δ Si =0.1 мкм, со скоростью VH=13×103 o/c. Как видно из рисунка, можно выделить три характерные области:



Рис. 2. Зависимости температуры (T) и скорости химического тепловыделения (dq/dt) от времени при линейном нагреве Mo/Si пары: δ_{Si} =0.1 *мкм*, V_H=13x10³ °/c, T_{макс}=1600°C.

I – при температурах ниже температуры плавления кремния (T_{nn}^{Si} =1410°С), а именно, в области T=1150-1350°С взаимодействие протекает по схеме Мо(тв.)+Si(тв.) и характеризуется положительным тепловыделением со следующими параметрами: длительность Δt_1 , максимальная скорость тепловыделения V_{1макс}. при температуре T_{1макс}. (зона I).

II — взаимодействие по схеме Мо(тв.) + Si(ж.), которое начинается сразу после плавления кремния. Эту зону можно характеризовать длительностью тепловыделения Δt_2 , максимальной скоростью тепловыделения V_{2макс} при температуре T_{2макс} (зона II). Дополнительные эксперименты с закалкой процесса путем выключения электронагрева на различных этапах развития процесса показали, что конец реакции с ин-

тенсивным тепловыделением соответствует моменту полного израсходования кремния.

III – относительно узкая и сильно отрицательная область функции тепловыделения между зонами I и II соответствует плавлению кремния. Глубина эндотермической стадии порой доходит до нескольких сот *кал/см²·с.* Очевидно, что реакция молибдена с кремнием интенсивно протекает и в этой стадии, однако из-за экранирующего действия сильноэндотермической стадии плавления кремния она четко не проявляется и невозможно измерить скорость процесса. Длительность этой стадии ($\Delta t_{nn.} ~ 0.1-7 \ mc$) тем больше, чем толще слой кремния: она практически линейно зависит от δ_{si} и существенно слабо от скорости нагрева (рис. 3). Роль этой стадии и ее возможное влияние на закономерности тепловыделения будет обсуждена позже.



Рис. З. Зависимость длительности плавления кремния от толщины слоя кремния при различных скоростях нагрева образцов.

Отметим, что вид функции тепловыделения, в частности, относительные интенсивности процесса в указанных двух стадиях, а также закономерности структурообразования существенным образом зависят от толщины слоя кремния и в меньшей мере – от скорости нагрева образцов. Рассмотрим влияние этих параметров на развитие процесса подробнее.

1. Закономерности тепловыделения

1.1. Влияние толщины слоя кремния. Влияние толщины слоя кремния на закономерности химического тепловыделения при взаимодействии молибдена с кремнием изучалось при линейном нагреве образцов с различными скоростями нагрева (Vн=(4x75) x103 o/c). Для этой цели использовались Si/Mo-пары с толщиной слоя кремния от 0.01 до 1 мкм.

На рис. 4а-г приведены кривые функции тепловыделения, полученные при нагреве Мо-нитей, покрытых слоем кремния различной толщины (δSi=0.03; 0.05; 0.3 и 0.7

мкм), со скоростью нагрева Vн=13x103 о/с в атмосфере гелия, PHe=600 Topp. Отметим, что область толщин слоев кремния δSi<0.25 мкм, которая представляет наибольший интерес с точки зрения механизма силицирования субмикронных и наноразмерных частиц металла, исследуется впервые в данной работе. Можно отметить следующие характерные особенности процесса.



Рис. 4. Зависимости температуры (T) и скорости химического тепловыделения (dq/dt) от времени при линейном нагреве Mo/Si-пары с различной толщиной слоя кремния: a – δsi=0.03; б – 0.05; в – 0.3 и г – 0.7 *мкм*. V_H=13x10³ °/*C*, T_{MAKC}=1600°C, P_{He}=600 *Topp*.

Прежде всего, заметим, что в случае достаточно тонких слоев кремния ($\delta_{Si}=0.03$ *мкм*, рис. 4а, и 0.05 *мкм*, рис. 4б) зарегистрирована только одна положительная область функции тепловыделения, которая проявляется до достижения температуры плавления кремния. При этом появившаяся вслед за ней первая узкая отрицательная область dq/dt при $\delta_{Si}=0.05$ *мкм* соответствует плавлению кремния (на что указывает провал температуры на кривой T(t) вблизи T_{nn}^{Si} , рис. 4б). Описанное явление обусловлено полным расходованием кремния уже на первой стадии процесса (рис. 4а), либо реакция заканчивается в процессе плавления оставшейся части кремния (рис. 4б). Природа другой отрицательной области функции тепловыделения на рис. 4а, будет обсуждена в разделе 2 (закономерности фазо- и структурообразования).

При превышении толщины слоя кремния (δsi>0.05 *мкм*) появляется вторая стадия тепловыделения (рис. 4в,г): реакция молибдена с остаточным кремнием продолжается при температуре выше температуры плавления кремния. Видно, что с повышением толщины слоя кремния местоположение зоны тепловыделения II сдвигается к области с постоянной температурой (Тмакс=1600°С). Кроме того, изменение бsi сильно влияет на абсолютное значение максимальной скорости V_{2макс} и на длительность тепловыделения в этой стадии.

Примечательно, что в определенной области толщин слоя кремния (δ_{Si}=0.2-0.3 *мкм*) скорость тепловыделения на второй стадии настолько повышается, что превышает уровень теплопотерь даже в среде гелия. В результате этого наступает перегрев образца и отклонение температуры от заданного пути (рис. 4в).



Рис. 5. Влияние толщины слоя кремния на: а – максимальные скорости тепловыделения на I ($V_{1 \text{макс}}$) и II ($V_{2 \text{макс}}$) стадиях, б – длительности тепловыделения в I (Δt_1) и II зоне (Δt_2), в – на T_1 макс и $T_{2 \text{макс}}$. Т макс =1600°С, V_{H} =13.000 °/*C*.

На рис. 5а-в представлены зависимости основных параметров реакции, а именно, максимальных значений скоростей тепловыделения на первой и второй стадиях (V_{1макс} и V_{2макс}), длительности тепловыделения в I (Δ t₁) и II зонах (Δ t₂), а также значения температур, соответствующие максимальным скоростям тепловыделения T_{1макс} и T_{2макс} от δ si. Как видно, изменение толщины слоя кремния сильно влияет на V_{2макс} (рис. 5а) и на Δ t₂ (рис. 5б). В области относительно толстых слоев кремния (δ si=0.25÷ 1.0 (3.0) *мкм*), аналогично [39], наблюдается значительный рост V_{2макс} с уменьшением δ si (рис. 5а). Так, уменьшение толщины кремниевого слоя от 1.0 до 0.3 *мкм* (при V_н=13x10³ °/*c*) приводит к 3-4-кратному повышению максимальной скорости V_{2макс}, несмотря на более высокую среднюю температуру протекания реакции для случаев с более толстыми слоями кремния. При δ si=0.25-0.3 *мкм* наступает мак-

симум на зависимости V_{2макс} от δ_{Si} (рис. 5а): дальнейшее уменьшение δ_{Si} приводит к понижению скорости тепловыделения, т. к. максимум тепловыделения наступает при более низкой температуре Т_{2макс}, ближе к температуре плавления кремния (T_{nn}^{Si} <T_{2макс}<T_{макс}=1600°C). При δ_{Si} (0.05 *мкм*, как уже было отмечено выше, вторая стадия тепловыделения вовсе отсутствует, т.е. V_{2макс}=0 (рис. 4а,б и рис. 5а).

Относительно зависимостей параметров первой стадии тепловыделения можно отметить, что все они слабо зависят от δ_{Si} (рис. 5а-в). Заметим, однако, что, если Δt_1 и $T_{1 макс}$ проявляют тенденцию к росту при увеличении \Box_{Si} , то зависимость $V_{1 макс}$ от δ_{Si} , подобно зависимости $V_{2 макс}$ от δ_{Si} , имеет слабовыраженный максимум при δ_{Si} =0.2-0.4 мкм.

1.2. Влияние скорости нагрева. Другим важным параметром, который наряду с толщиной слоя кремния влияет (хотя не так сильно) на кинетику реакции Мо+Si, является скорость нагрева. На рис.ба-в представлены характерные кривые тепловыделения (dq/dt), полученные при различных скоростях нагрева (V_{μ} =4x10³, 13x10³ и 75x10³ °/c) молибденовых нитей с одинаковой толщиной слоя кремния (δ_{Si} =0.2 *мкм*) до температуры T_{max} =1600°С. Как видно из рис.бб,в, при высоких скоростях нагрева местоположение зоны реакции II в большей мере сдвигается в область с максимальной (постоянной) температурой. При низких же скоростях нагрева, наоборот, процесс тепловыделения может полностью заканчиваться до достижения максимальной температуры (рис.ба,б).



Рис. 6. Зависимости температуры (Т) и скорости химического тепловыделения (dq/dt) от времени при линейном нагреве Mo/Si-пары с различными скоростями нагрева: а – V_н= 4x10³, б – 13x10³ и в – 75(10³ °/*c*). (δsi=0.2 *мкм*, Т_{макс}=1600°C, Р_{Hе}=600 *Торр*).

Кроме того, общей тенденцией является повышение максимальных скоростей химического тепловыделения в обеих стадиях при повышении скорости нагрева, независимо от толщины слоя кремния (рис. 6а-в и рис. 7а,б). Например, для относительно тонких слоев кремния ($\delta_{Si}=0.1-0,3~$ *мкм*) повышение скорости нагрева с 4х10³ до 75х10³ °/с приводит к более чем 2-4-кратному возрастанию V_{2макс} (рис. 7б) и более чем 10-кратному возрастанию V_{1макс} (рис. 7а).



Рис. 7. Влияние скорости нагрева на максимальные скорости химического тепловыделения в зонах I (V1 макс) (а) и II (V2 макс) (б).

Из рис. 7б также следует, что с понижением скорости нагрева образцов наблюдается существенное расширение области по толщине слоя кремния, при котором взаимодействие молибдена с кремнием заканчивается уже на первой стадии, т.е. вторая стадия тепловыделения вообще отсутствует. Так, если при V_H=75x10³ °/*с* предельное значение δ_{Si} =0.05 *мкм*, а при V_H=13x10³ °/*с* – 0.075 *мкм*, то в случае V_H= 4(10³ °/*с* оно составляет уже 0.12 *мкм*.

2. Закономерности фазо- и структурообразования

На рис. 16 приведена микрофотография поверхности исходных образцов с толщиной слоя кремния 0,2 *мкм*. Можно заметить, что поверхность кремния имеет зернистую структуру, причем характерный размер зерен сравним с толщиной слоя. При нагреве этих образцов в инертной среде (гелий) происходит значительное изменение морфологии поверхности, которое четко проявляется на микрофотографиях образцов, закаленных на различных этапах развития процесса.

На рис. 8 и 9 представлены последовательности трансформации микроструктуры поверхности нитей с толщиной слоя кремния 0.2 и 1.0 *мкм*, соответственно, при их нагреве по термограмме рис.6в (V_н=75х10³ °/*с*, Т_{макс}=1600°С). Можно заметить, что до достижения температуры плавления кремния поверхность нитей не претерпевает существенного изменения (рис. 8а и 9а). При достижении же T_{nn}^{Si} кремний плавится, и начальная зернистая структура слоя полностью разрушается (рис. 8б и 9б). Однако при этом появляются новые зерна субмикронных размеров, первичный размер которых никак не связан с толщиной слоя кремния (сравнить рис. 8б и 96 с рис. 8а и 9а). Эти зерна по мере протекания процесса быстро растут, пока весь кремний не прореагирует, и достигают определенных размеров (рис. 8в и 9в-г). Методом локального

рентгеноспектрального анализа (ЛРСА) установлено, что состав зерен близок к составу фазы MoSi₂, а сплошная аморфоподобная матрица представляет собой свободный кремний. Рост зерен MoSi₂ практически прекращается после полного израсходования кремния (ср. рис. 8г и 9г с рис. 8в и 9д), которое наступает в конце второй зоны тепловыделения (рис.2). Заметим, что при V_H=75(10³ °/*с* конец второй стадии тепловыделения наступает при t=0.033 *с* (δ_{Si} =0.2 *мкм*) и t=0.16 *с* (δ_{Si} =1.0 *мкм*). При этом конечный размер зерен MoSi₂ тем больше, чем толще был слой кремния (ср. рис. 8 г и 9д).



Рис. 8. Микрофотографии поверхностей нитей, закаленных на различных стадиях взаимодействия ($\delta_{Si}=0.2$ *мкм*, V_H=75Ч10³ °/*c*): (а) – исходная нить и нить, нагретая при t_H=0.025 *c*; (б) – 0.03; (в) – 0.035; (г) – 0.1.



Рис. 9. Микрофотографии поверхностей нитей, закаленных на различных стадиях взаимодействия (δsi=1.0 *мкм*, V_в=75х10³ °/*c*): (а) – исходная нить и нить, нагретая при t_в=0.0285 *c*; (б) – 0.030; (в) – 0.0354; (г) – 0.16; (д) – 0.5; (е) – 10.

Существенные изменения поверхности нитей, наблюдаемые при более продолжительном нагревании образцов, обусловлены последовательными фазовыми превращениями поверхностного слоя: MoSi₂ δ MosSi₃ (рис. 9е) и далее MosSi₃ →MosSi.



Рис. 10. Микрофотографии фрагментов поперечного сечения Мо-образцов, закаленных на различных стадиях взаимодействия: a – t=0.0276 *c*, б – 0.0354, в – 0.2, г – 5.4, д – 10, е – 50. (δ_{Si}=1.0 *мкм*, V_i=75x10³ °/*c*).

Последовательность формирования и роста фаз при взаимодействии Мо с кремнием показана на рис. 10 в виде микрофотографий поперечного сечения образцов, закаленных при различных временах реагирования Мо-нитей со слоем кремния толщиной 1 *мкм*. При температурах ниже T_{nn}^{Si} , а именно, в области первой зоны тепловыделения, как видно из рис. 10а, наблюдается формирование тонкого, еще не совсем сплошного слоя продукта. Методом ЛРСА показано (рис. 11а, табл.), что состав этой прослойки близок к составу фазы MoSi₂ (атомное соотношение Mo:Si=31.6:68.42≈1:2). После достижения температуры плавления кремния наблюдается формирование зерен MoSi₂ в объеме расплава кремния. На этой стадии развития процесса эти зерна еще не образуют сплошного слоя MoSi2 вокруг Мо-нити, но расположены преимущественно в ее непосредственной близости. По мере протекания процесса появляются новые зерна, одновременно происходит рост уже имеющихся зерен (рис. 11б) и в результате формируется сплошной слой MoSi2. Заметим, что к этому времени еще имеется избыток свободного, непрореагировавшего кремния, и наряду с основным слоем образуется также достаточно тонкий и компактный слой фазы Мо₅Si₃ между металлической сердцевиной и слоем MoSi₂ (рис.10б). В период интенсивного тепловыделения происходит одновременный рост обоих слоев по механизму реакционной диффузии, причем толщина слоя Мо5Si3 существенно уступает толщине слоя MoSi2. После полного израсходования кремния (конец тепловыделения) происходит преимущественный рост фазы Мо5Si3 за счет фазы MoSi2 (рис. 10в и рис. 11в), и в определенный момент времени вся диффузионная зона состоит из фазы MosSi3 (рис. 10г). Дальнейший отжиг сформировавшейся диффузионной пары Мо₅Si₃/Мо приводит к появлению слоя фазы Мо₃Si между металлической сердцевиной и слоем MosSi3 (рис. 10д и рис. 11г), которая при более продолжительном отжиге полностью переходит в однофазную зону Мо₃Si (рис. 10e).



Рис. 11. ЛРСА спектры отмеченных на рис. 10 участков Мо-образцов, закаленных на разных стадиях взаимодействия: а – участок 2, б – 4, в – 7, г – 9.

Нужно отметить, что указанные фазовые превращения протекают тем быстрее, чем тоньше слой кремния. Так, если при $\delta_{Si=1}$ *мкм* диффузионная зона целиком состоит из фазы MosSi3 при t1=5 *с* и полностью превращается в фазу MosSi за t2=50 *с*, то при $\delta_{Si=0.03}$ *мкм* эти же времена составляют всего t1=0.05 и t2=2 *с*, соответственно (при $V_{H}=75.10^3 \text{ °/} c$). Как уже отмечалось в первом разделе экспериментальной части, при достаточно тонких слоях кремния последний полностью расходуется до достижения температуры плавления на формирование дисилицидной фазы. В результате этого превращение слоя MoSi2 в слой фазы MosSi3 также может протекать до достижения температуры плавления кремния. Причем, как следует из рис.4а и б, переход фазы MoSi2 в фазу MosSi3 conpoвождается поглощением тепла, а переход последнего в MosSi – тепловыделением (рис.12, t>0.08 *с*).



Измеренные значения концентраций Si и Mo на разных участках прореагировавших образцов и их фазовый состав

Рис. 12. Зависимости температуры (T) и скорости химического тепловыделения (dq/dt) от времени при линейном нагреве Mo/Si-пары до T_{макс}=1600°C. δsi=0.03 *мкм*, V_H=13x10³ °/c, P_{He}=600 *Topp*. Продолжительный нагрев при T= T_{макс}=1600°C.

Обсуждение результатов

В работе получены новые данные по кинетике химического тепловыделения и динамике формирования различных фаз в системе Mo-Si в условиях быстрого линейного нагрева для микро- и наноразмерных образцов. Работа вносит определенный вклад в наши представления о механизме взаимодействия в диффузионной паре Me/Si в неизотермических условиях с образованием многофазных продуктов. Полученные в настоящей работе и в [39] данные вместе охватывают весь диапазон основных экспериментальных параметров (толщина слоя кремния, моделирующей размер частиц металла и скорость нагрева), представляющих интерес с точки зрения получения силицидных фаз в режиме горения.

Сначала обсудим влияние толщины слоя кремния. При исследовании закономерностей химического тепловыделения в области δ_{si} >0.25 *мкм* в [39] было зарегистрировано преимущественно одностадийное тепловыделение, которое начинается сразу с момента плавления кремния. При этом было установлено значительное увеличение максимальной скорости химического тепловыделения при уменьшении δ_{si} .

Между тем, как следует из полученных в настоящей работе данных (рис.2, рис.4в,г и рис.6а-в), в широком диапазоне толщин слоев кремния и скоростей нагрева образцов имеет место двухстадийное тепловыделение. С другой стороны, зависимость V_{2макс} от δ_{si} , установленная в новом, существенно расширенном диапазоне изменения δ_{si} , носит не монотонный характер, как в [39], а имеет максимум при (δ_{si})*=0.17-0.25 *мкм* (рис. 5а и 76). При этом, если в области относительно толстых слоев Si эта зависимость полностью совпадает с установленной в [39], то при $\delta_{si} < (\delta_{si})^*$ наблюдается обратная картина: с уменьшением δ_{si} скорость тепловыделения падает и доходит до нуля при определенном значении $\delta_{si}=(\delta_{si})_{\circ}$.

Чтобы объяснить вышеуказанное явление, обратим внимание на следующие обстоятельства.

- I. Второй стадии тепловыделения предшествует плавление кремния, во время которого имеет место интенсивное взаимодействие Мо с кремнием, приводящее к некоторому торможению процесса. Если учесть также, что длительность стадии плавления линейно растет с увеличением толщины слоя кремния (рис.3), то становится ясным сильное уменьшение максимальной скорости тепловыделения V_{2макс} с увеличением δsi. Заметим, что при δsi >(δsi)* максимум скорости тепловыделения V_{2макс} практически наступает при Т_{макс}=1600°С.
- II. Что касается зависимости V_{2макс} от δ_{Si} в области δ_{Si} <(δ_{Si})*, то в данном случае максимум скорости тепловыделения V_{2макс} наступает до достижения максимальной температуры (T_{2макс}<1600°C), причем T_{2макс} тем ниже, чем меньше δ_{Si} (рис. 5в). Последнее обуславливает и падение V_{2макс} с уменьшением δ_{Si}.

Условие V_{2макс}=0 при δ_{Si}≤(δ_{Si})₀>0 означает, что для более тонких слоев кремния тепловыделение протекает одностадийно и заканчивается на стадии плавления кремния. При этом, как следует из рис. 7б, область одностадийного тепловыделения тем шире по δ_{Si}, чем меньше скорость нагрева.

На основании полученных в настоящей работе и [39] данных построена V_н-δ_{si} диаграмма режимов силицирования молибдена (рис.13), где можно выделить четыре характерные параметрические области протекания процесса.

В области 1 весь кремний реагирует с молибденом по механизму Мо(тв.) + Si(тв.) с образованием фазы MoSi₂.

В области 4 (находится в диапазоне более толстых слоев кремния, Пб_{Si}>0.3 *мкм* и на диаграмме не указана) взаимодействие также практически протекает одностадийно, но уже при максимальной температуре и по механизму Mo(тв.) + Si(ж.) с образованием фазы MoSi₂.

В области З взаимодействие имеет двухстадийный характер: первая стадия – Мо(тв.) + Si(тв.) а вторая стадия – Мо(тв.) + Si(ж.).

Между областями 1 и 3, а именно, в области 2 взаимодействие начинается по механизму Мо(тв.) + Si(тв.) и заканчивается на стадии плавления кремния (при Тпл.) с образованием фазы MoSi₂.



Рис. 13. V_н - δ_{Si} диаграмма режимов силицирования молибдена.

III. Учитывая, что толщина слоя кремния моделирует тот размер частиц металла, которому соответствует та или иная стехиометрия (Mo:Si) конечного продукта, в частности Mo:Si=1:2, можно предполагать, что в области достаточно малых размеров частиц молибдена неизотермическое силицирование молибдена в широком диапазоне скоростей нагрева системы может протекать по чисто твердофазному механизму. Данные по скорости нагрева вещества в волне CBC дисилицида молибдена по разным источникам составляют от 1000 до 13000°/с [17,24,43,44]. Этим скоростям нагрева на рис.13 соответствует предельная толщина слоя кремния δsi=0.08-0.12 *мкм*. Исходя из этого можно предполагать, что в определенном диапазоне размера частиц молибдена, вопреки установившемуся мнению, волна горения в смеси Мо+2Si может распространяться при температуре ниже температуры плавления кремния.

Как следует из формулы (1), δsi=0.1 *мкм* соответствует размер частиц молибдена, равный примерно 0.2 *мкм*. Следовательно, именно в области размера частиц молибдена менее 0.2 *мкм*, т.е. в наноразмерной области порошков молибдена (и кремния) возможна реализация режима строго твердофазного горения смеси Mo+2Si.

Другой вопрос, который часто дискутируется в литературе, – это механизм формирования дисилицидной фазы при $T > T_{nn}^{Si}$. Из данных, представленных в разделе 2, следует, что после плавления кремния первичной стадией процесса является растворение молибдена в жидком кремнии с дальнейшей кристаллизацией зерен MoSi₂ в объеме расплава. Далее, после того, как эти зерна формируют сплошной слой MoSi₂, сопровождающийся также формированием тонкой прослойки Mo₅Si₃, прямое раство-

рение молибдена в жидком кремнии прекращается. Заметим, что к этому моменту, как следует из рис.10б, значительная часть кремния оставалась еще непрореагировавшей. Дальнейшее взаимодействие продолжается по механизму реакционной диффузии – преимущественно путем диффузии атомов кремния через растущие силицидные слои [33]. Таким образом, исходя из полученных результатов можно констатировать, что химическое тепловыделение при взаимодействии молибдена с жидким кремнием обусловлено двумя механизмами: растворением молибдена в расплаве кремния с дальнейшей кристаллизацией зерен MoSi2 и реакционной диффузией кремния с формированием и ростом компактных силицидных слоев, преимущественно MoSi2. Описанные закономерности фазо- и структурообразования полностью согласуются с нашими прежними данными, полученными для систем Mo-Si и W-Si в изотермических условиях [26,40,45-47].

Обобщая полученные результаты, можно отметить следующее. Силицирование частиц молибдена в широком диапазоне толщин слоев кремния и скоростей нагрева при 1000-1600°С протекает двухстадийно: первая стадия соответствует взаимодействию по механизму Mo(тв.)+Si(тв.), вторая – Mo(тв.)+Si(ж.). На обеих стадиях первичным продуктом является MoSi2. Впервые установлено, что в области достаточно тонких слоев кремния взаимодействие Mo с Si имеет одностадийный характер и завершается до достижения температуры плавления кремния: с понижением скорости нагрева происходит значительное расширение этой области.

При взаимодействии молибдена с жидким кремнием максимальная скорость тепловыделения V_{2макс} зависит как от скорости нарастания температуры и толщины слоя кремния, так и от длительности его плавления. При этом зависимость V_{2макс} от толщины слоя кремния описывается кривой с максимумом, т.е. при определенной толщине слоя скорость процесса имеет максимальное значение. Этому явлению дано объяснение с учетом определяющей роли неизотермичности взаимодействия и длительности стадии плавления кремния.

Химическое тепловыделение при взаимодействии Мо с жидким кремнием обусловлено двумя механизмами: растворением Мо в расплаве кремния с дальнейшей кристаллизацией зерен MoSi2 и реакционной диффузией Si с формированием и ростом компактных силицидных слоев, преимущественно MoSi2.

ՈՉ ԻՉՈԹԺՎՈԵՅՎՈՆՅՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻԿՐՈ- ԵՎ ՆԱՆՈՉԱՓՄԻ Mo-Si ԴԻՖՈՒՉԺՈՒՁ ՄՎՈԳՅԴՈՆՄ

Մ. Ա. ԱՂԱՅԱՆ, Հ. Ա. ՉԱՏԻԼՅԱՆ և Ս. Լ. ԽԱՌԱՏՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են քիմիական ջերմանջատման կինետիկան և սիլիցիդալին ֆազերի առաջազման օրինաչափությունները Mo/Si դիֆուզիոն զույգում՝ կախված սիլիզիումի շերտի հաստությունից ($\delta_{si}=0.01\div1$ մկմ) և տաքազման արագությունից $(V_{m}=(4\div75). 10^{3} \text{ o/dpd})$: Փորձանմուշները գծային օրենքով տաքացվել են ուղղակիորեն հաստատուն էլեկտրական հոսանքով մինչև 1600°C, այնուհետև ջերմաստիձանը պահվել է հաստատուն։ Ցույց է տրվել, որ նշված ոչ իզոթերմ պայմաններում փոխազդեցությունն ընթանում է երկու հիմնական էկզոթերմ ջերմանջատման փուլով, որոնք իրարիզ բաժանված են սիլիցիումի հայման (1410°C) էնդոթերմ փուլով։ Առաջին փույում (T<Tsihund) պրոցեսն ընթանում է պինդ (Mo) + պինդ (Si), մինչդեռ երկրորդ փույում` պինդ (Mo) + հեղուկ (Si) մեխանիզմով` երկու դեպքում էլ MoSi2 սիլիցիդային ֆազի առաջացմամբ։ Բացահայտվել է, որ սիլիցիումի շերտի հաստությունից կախված պրոցեսը դրսևորում է մի քանի առանձնահատկություններ, այն է. ա). δsi-ի որոշակի արժեքի դեպքում ջերմանջատման երկրորդ փուլի արագությունն ունի առավելագույն արժեք, և բ). δsi<0.1 մկմ դեպքում պրոցեսն ընթանում է մեկ՝ պինդֆազային փոխազդեցության մեխանիզմով։ Նշված երևույթները բացատրվել են ելնելով պրոցեսի ոչ իզոթերմ ընթանալու բնույթով և սիլիցիումի հայման պրոցեսի տևողության ազդեցությամբ։ Եյնելով փորձանմուշների ռենտգենսպեկտրալ միկրոանալիզի տվյալներից, որոնք իրականացվել են փոխազդեցության տարբեր փուլերում, առաջարկվել է ոչ իզոթերմ պալմաններում մոլիբդենի սիլիցավորման մեխանիզմ։

DISTINCTIVE FEATURES OF NONISOTHERMAL INTERACTION IN MICRO- NANOSIZE Mo/Si DIFFUSION COUPLE

M. A. AGHAYAN, H. A. CHATILYAN and S. L. KHARATYAN

Yerevan State University 1, A. Manoukyan Str., Yerevan, 0025, Armenia A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics NAS RA 5/2, P. Sevak Str., Yerevan, 0014, Armenia E-mail: suren@ichph.sci.am

The heat release, as well as phase and microstructure formation laws for Mo-Si system at non-isothermal annealing of micro- and nanoscale Si/Mo diffusion couple were investigated within the temperature range 1000-1600°C, modeling the molybdenum silicides synthesis in SHS waves. The main goal of the work was to study the influence of silicon layer thickness (modelling the metal particle size in Mo-Si mixture), as well as heating rate (V_h =(4÷75).10³ °/s) on the reaction kinetics and phase formation laws at silicon layer ranging from 10 *nm* to 1 μm .

It was shown that at heating of Si/Mo diffusion couples chemical heat release occurred by two stages: first stage - at temperatures below the melting point of silicon by the mechanism of solid (Mo) + solid (Si), and second stage – starting just with the melting of silicon: solid (Mo) + liquid (Si). The above-mentioned heat release stages were separated by the endothermic stage of silicon melting. Nevertheless at Si layer thickness less than about 100 nm, the only single-stage heat release was registered at temperature below the melting point of silicon by the solid-phase mechanism: that means before reaching the silicon melting point all silicon was already consumed. Note that in all cases the primary phase formed is MoSi₂.

Proceeding from the EDS (energy-dispersive X-ray spectrometry) analyses data performed at various stages of interaction, a new mechanism of Mo siliconizing at non isothermal conditions was suggested.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Schlichting J. // High Temp.-High Press., 1978, v.10, p.241.
- [2] Jeng Y.L., Lavernia E.J. // J. Mater. Sci., 1994, v.29, p.2557.
- [3] Petrovic J.J., Vasudevan A.K.// Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 1994, v.322, p.3.
- [4] Petrovic J.J. // Ceram. Eng. Sci. Proc., 1997, v.18, p.3.
- [5] Dasgupta T., Bhattacharya A.K., Umarji A.M. // Solid State Communications, 2003, v.126, p.573.
- [6] Yu, C. C., Jagasivamani, V., Kumar, R., Sudarshan, T.S. // Materials Science and Technology, 1997, v.13, №11, p. 887.
- Bokhonov B.B., Konstanchuk I.G., Boldyrev V.V. // J. of Alloys and Compounds, 1995, v.218, p.190.
- [8] Schwarz R.B., Srinivasan S. R., Petrovic J.J., Maggiore C.J. // Mat. Sci. Eng., 1992, v.A155, p.75-84.
- [9] Lee P.-Y., Chen T.-R., Yang J.-L., Chin T.S. // Mater. Sci. Eng., 1995, v.A192/193, p.556-562.
- [10] Hardwick D.A., Martin P.L., Moores R.J. // Scripta Metal. 1992, v.27, p391.
- [11] Merzhanov A.G., Borovinskaya I.P. // Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, v.204, №2, p.366.
- [12] Merzhanov A.G., Borovinskaya I.P. // Combust. Sci. Technol., 1975, №10, p.195.
- [13] Саркисян А.Р., Долуханян С.К., Боровинская И.П., Мержанов А.Г.// Физика горения и взрыва, 1978, №3, с.49.
- [14] *Мартиросян Н.А., Долуханян С.К., Мкртчян Г.М., Боровинская И.П., Мержанов А.Г.* // Порошковая металлургия, 1977, v. 175, №7, с.36.
- [15] Deevi S.C. // J. Mater. Sci. 1991, v.26, p.3343.
- [16] Саркисян А.Р., Долуханян С.К., Боровинская И.П. // Порошковая металлургия, 1978, v.174, №6, c.14.
- [17] Deevi S.C. // Materials Science and Engineering, 1992, v.A149, p.241.
- [18] Deevi S.C. // Int. J. of Refractory Metals & Hard Materials, 1995, v.13, p.337.
- [19] Jo S.-W., Lee G.-W., Moon J.-T., Kim Y.-S.//Acta Mater., 1996, v.44, №11, p.4317.
- [20] Zang S., Munir Z.A.// J. Mater. Sci., 1991, v.26, p.3685.
- [21] Subrahmanyam J. // J. Mater. Res., 1994, v.9(10), p.2620.
- [22] Xu J.G., Zhang B.L., Li W.L., Zhuang H.R., Jiang G.J.// Ceram.Int, 2003, v.29, p.543.
- [23] Gao J.Y., Jiang W., Wang G.// Key Eng. Mater., 2005, v.280-283, p.1467.
- [24] Yeh C.L., Chen W.H.// J. of Alloys and Compounds, 2007, v.438, p.65.

- [25] Bartlett R. W., Prisbrey K.A.// Metallurgical and Materials Transactions A, 1996, v.27A, p.2086.
- [26] Galstyan G.S., Chatilyan H.A., Kirakosyan A.G., Kharatyan S.L., Mukasyan A.S., Varma A. // Defect and Diffusion Forum, 2005, v.237-240, p.873.
- [27] Bartlett R. W., Gage P.R., Larsson P.A.// Transactions of the Metallurgical Society o AIME, 1964, v.230, p.1528.
- [28] Hilling W. B., Usta M.// J. Am. Ceram. Soc., 1997, v.8, №7, p.1723.
- [29] Christian F., Narita T.// Materials Transactions, JIM, 1998, v.39, №6 p.658.
- [30] Tortorici P.C., Dayananda M.A.// Scripta Materialia, 1998, v.38, №12, p.1863.
- [31] *Tortorici P.C., Dayananda M.A.*// Metallurgical and Materials Transactions A, 1999, v.30A, p.545.
- [32] Yoon J.-K., Byun J.- Y., Kim G.-H., Kim J.-S., Choi Ch.-S. // Thin Solid Films, 2002, v.405, p.170.
- [33] Byun J.-Y., Yoon J.-K., Kim G.-H., Kim J.-S., Choi Ch.-S.// Scripta Materialia, 2002, v.46 p.537.
- [34] Yoon J.-K., Lee J.-K., Lee K.-H., Byun J.-Y., Kim G.-H., Hong K.-T.// Intermetallics, 2003, v.11, p.687.
- [35] Kharatyan S.L., Chatilyan H.A., Harutyunyan A.B. // Defect and Diffusion Forum, 2001, v.194-199, p.1557.
- [36] Chatilyan H.A., Arakelyan L.H., Kharatyan S.L. // Defect and Diffusion Forum, 2005, v.237-240, p.867.
- [37] Kharatyan S.L., Chatilyan H.A., Galstyan G.S. // Thin Solid Films, 2008, v.516, p.4876.
- [38] Chatilyan H.A., Kharatyan S.L., Harutyunyan A.B. // Materials Science and Engineering, 2007, v. A459, p.227.
- [39] Kharatyan S.L., Chatilyan H.A., Mukasyan A.S., Simonetti D.A., Varma A. // AIChE Journal, 2005, v.51, №1, p.261.
- [40] *Kharatyan S.L., Chatilyan H.A.*// Intern. J. of SHS, 1999, v.8, №1, p.31.
- [41] Kharatyan S.L., Chatilyan H.A., Arakelyan L.H. // Mater. Res. Bull., 2008, v.43, issue 4, p.897.
- [42] High-Speed Scanning Electrothermography. Booklet. SHS Kinetics Research Group, A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics NAS of Armenia. NFSAT Commercialization of Products/Results Support Program, Yerevan, 2006.
- [43] Wang L.L., Munir Z.A. // Metallurgical and Materials Transactions B, 1995, v.26B, p.595.
- [44] Chae S. W., Son C.H., Kim Y.S. // Materials Science and Engineering, 2000, v.A279, p.111.
- [45] Kharatyan S.L., Chatilyan H.A., Merzhanov A.G. // Book of Abstracts. Intern. Symposium on SHS, 1999, Moscow, p.15.
- [46] Харатян С.Л., Чатилян А.А. // Физика горения и взрыва, 2000, т.36, №3, с.65.
- [47] Харатян С.Л. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Теория и практика / под ред. А.Сычева, Черноголовка, Территория, 2001, с.157.